
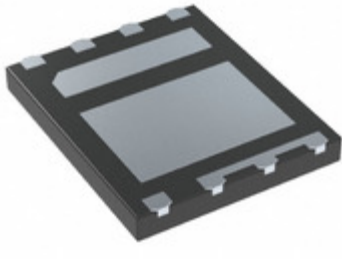
	<p>SIZ998DT-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIZ998DT-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR</p> <p>Datenblätter:  SIZ998DT-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 3478 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



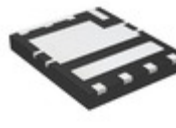




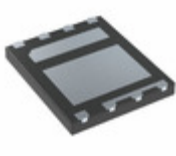
Spezifikationen

Teilenummer	SIZ998DT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3478 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPair®
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.7 mOhm @ 15A, 10V, 2.8 mOhm @ 19A, 10V
Leistung - max	20.2W, 32.9W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	SIZ998DT-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	930pF @ 15V, 2620pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.1nC @ 4.5V, 19.8nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual), Schottky
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual), Schottky 30V 20A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc), 60A (Tc)

SIZ998DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ998DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ998DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIZ998DT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIZ998DT-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SIZ980DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR</p>	 <p>SIZF906ADT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CHAN 30V</p>	 <p>SIZB60-4102 N/A N/A SOP-4P</p>
 <p>SIZB60-4072 SOP-4 SOP-4 SHINDEN</p>	 <p>SIZ988DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR</p>	 <p>SIZ920DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 40A PWRPAIR</p>	 <p>SIZ926DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 25V 8-POWERPAIR</p>

SIZ998DT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

SIZ998DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIZ998DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ998DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ998DT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ998DT-T1-GE3
SIZ998DT-T1-GE3 Electronic	SIZ998DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ998DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ998DT-T1-GE3-Bild	SIZ998DT-T1-GE3-Teil
SIZ998DT-T1-GE3 Preis	SIZ998DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ998DT-T1-GE3 Bild	SIZ998DT-T1-GE3 Aktie	SIZ998DT-T1-GE3 Inventar
SIZ998DT-T1-GE3 Neu	SIZ998DT-T1-GE3 Original	SIZ998DT-T1-GE3 garantiert	SIZ998DT-T1-GE3 RFQ	SIZ998DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited